EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62098740

PUBLICATION DATE

08-05-87

APPLICATION DATE

25-10-85

APPLICATION NUMBER

60238942

APPLICANT: TOKYO ELECTRON LTD;

INVENTOR:

YANAGI YOSHIAKI;

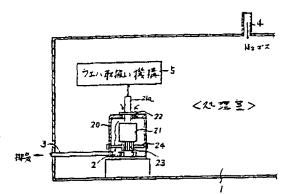
INT.CL.

H01L 21/68 B08B 5/02 F24F 7/06

TITLE

DUST PREVENTING SYSTEM OF

ROTARY MECHANISM



ABSTRACT :

PURPOSE: To make the adoption of specific motor subject to less dust production unnecessary by a method wherein any dust produced in a bearing part of rotary mechanism or inside a processing chamber is drawn into the negative pressure side to be exhausted outside.

CONSTITUTION: A wafer handling mechanism 5 is provided with torque by the axle 21a of a DC motor 2. A dust exhaust pipe 3 communicates with inside and outside of a box body 20 to be connected at the position not to obstruct a stator installed inside the box body 20. This exhaust pipe 3 may be composed of a flexible hose or a pipe made of metallic material. Now the pressure inside a processing chamber 1 is made higher than the outside pressure. Resultantly, the pressure inside the box body 20 of the DC motor 2 is made higher than outside pressure so that any particles, dust etc. produced inside the processing chamber 1 may be drawn into the dust exhaust pipe 3 through the intermediary of a bearing part 22 together with the other dust etc. produced at the rotary parts of the bearing part 22 to be exhausted outside.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-98740

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987)5月8日

H 01 L 21/68 B 08 B 5/02 F 24 F 7/06 7168-5F Z-6420-3B

C - 6634-3L 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

回転機構の発塵防止システム

②特 願 昭60-238942

②出 願 昭60(1985)10月25日

の発明者 柳

良 明

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株

式会社内

①出 願 人 東京エレクトロン株式

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

会社

N71 AN .!!

1. 発明の名称

回転機構の発展防止システム

2.特許請求の箱明

- (1) 処理室又はその準備者等の気密性のある室内に配置された回転機構と、この回転機構の筐体内部又は回転機構を包むケース内に連通する管とを有し、前記管は、前記処理室又はその準備室の外部に専出される排気部分に接続され、前記処理室又はその準備室内の圧力より排気側の外部の圧力が低い状態であることを特徴とする回転機構の発度防止システム。
- (2) 気密性のある窓は、半導体デバイス製造装置おける処理窓又はその準備窓であって、回転機構は、モータであり、このモータは、前記処理室又は準備室に配置された駆動機構の駆動線として使用されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の前伝機構の発度防止システム。
- (3) 俳気する旅速がほぼり、22m/sec以上であることを特徴とする特許別次の範囲第1項又

は第2項記載の回転機構の発展防止システム。 3.発明の詳細な説明

[発明の顕する技術分野]

木充明は、回転機構の免廃防止システムに関し、 特に、LSI(大規模集構回路)等の半導体デバイス製造装置とか、半部体の検査装置等における 半導体ウェハ(以下単にウェハ)の位置決め機構、 特にそのX-Yテーブルの駆動機構をはじめ、ウェハの自動搬送装置等に使用される回転機構部分 からの発度を防止するシステムに関する。

[従来の技術]

LSIの各種の検査装置をはじめとして、CV D装置、プラズマエッチング装置、蒸着装置、拡 設装置等の各種半導体デバイスの製造装置における半導体ウェハの処理については、発塵を振力避 けなければならない。これは、発應量の増加が製 品の少額りを悪くし、また、構度の高い検査に悪 影響を与えるからである。

発度の原因としては、ウェハ等に対する反応処 側の結果として発生するものと、ウェハを処理室

特開昭62-98740(2)

又はその準備室内に搬入し又は脚出するウェハ等の取り扱い機構。ウェハ等を破潰するXーYテーブル等の収動機構から発生するものとに大別される。

ところで、LSI技術の進步危候はきわめて急速であり、すでに1μm以下の微糊パターンを用いたLSIが作られている。こうしたサブミクロンレベルのLSIを製造するためには、当然のことながら不確定要素に影響されることの少ない、より制御性のよい高性能な製造プロセスが必要となる。

この一例として、プロセスの低温化と高速択性プロセスが挙げられる。 主としてプロセスの低温化は、化は、半導体内における不純物の再拡散を抑え、正確な不純物分布を実現するために必要である。特に、プロセス低温化は、LSIに使用されるグレイン成長を抑止するためにも、さらには基板結晶とその上の薄膜及び薄膜間の界面反応抑制にも有効である。一方、微細パターン形成用のエッチン

グあるいは海敷形成には、材料の差による高い進 択性が必須である。

このようなプロセスの低温化及び高速収性プロセスを実現する最大の要件は、反応に必要なガス成分以外の不要ガス成分が、プロセスが進行する反応室の雰囲気から殆ど完全に除去されていることである。すなわち、ウルトラクリーンプロセスは、超微細化しSI製造に必須の低温化プロセス及び高速収性プロセス実現に不可欠である。

反応労組気をクリーンにするためには、原料ガスポンペ (あるいは液化ガス容器:以後ガスポンペと総称する)から反応室までのガス供給系。反応室自体及びガス排気系のすべてがクリーンでなければならない。

これには、装置の駆動系でのパーティクル(粒子)、ダストの発生がなるべく少ないことが必須となる。特に、装置の可動系ににおけるパーティクルの発生は、ウェハ搬送装置又はX-Yテーブル等における機構系自体の構成上の問題であり、その構造が重要となる。

[解決しようとする問題点]

ウェハ搬送装置又はX-Yテーブル等における 機構系では、モーク等を用いた回転機構が使用さ れることが多く、発限を抑えたモータの使用を余 様なくされる。

しかし、このようなモータは、高値であり、発 應が全くなくなる分けではない。しかも良時間の 使用ではかなりの量の発酵をするという問題があ ス

第3図は、一般のDCモータについての発應量を測定した一例を示すものであって、そのカウント値は、数百カウントのレベルにあって、この状態では、そのまま半導体製造プロセス等で用いることはできない。

[発明の目的]

この発明は、このような従来技術の問題点等を 解決するものであって、半導体装置等の製造プロ セス、検査プロセスにおける装置の回転機構系で のパーテクルをほとんど充生させずに半導体デバ イスを取り扱うことができる回転機構の発露防止 システムを提供することを目的とする。 [問題点を解決するための手段]

この発明者が各種のモータについて実験した結果、モータの場合には、 植径の小さいダストに比べ、 粒径の大きいダストの鼠が多いということを 発見をした。 モしてその危機がを検討して見ると、 ペアリングとか、 ブランとか、 回転系で増動する 部分から多く発生する。 しかも、 その発興量は、 モータが高温になる程多く、 ホットスタートより もコールドスタートの方が少ないことである。

このような関点から前記ような目的を達成する ためのこの発明の回転機構の発應防止システムに おける手段は、処理室又はその準備を等の気気と のある室内に配置された回転機構と、この回転機 構の饱体内部又は回転機構を包むケース内に連通 する間とを有していて、この管は、処理室と の準備室の外部に専出され若しくは外部に写出を れる排気部分に接続されていて、処理室又はその 準備室内の圧力より排気側の外部の圧力が低い状 進になるようにするというものである。

特開昭62-98740(3)

【作用】

このように構成することにより、回転機構の軸 受部等から発生するグストや処理室内部で発生す るパーテクルを負圧側に吸引して処理室又はその 準備室等から外部へ排出することができる。

その結果、特別に発展の少ないモータ等を使用しなくても、通常のDCモータとか、ステッピングモータを使用することが可能となり、安価で長時間使用しても、発展の少ないシステムを提供することが可能となる。

[尖施例]

以下、この発明の一実施例について図面を用いて詳細に説明する。

第1図は、この発明の回転機構の発理防止システムを適用した一実施例の概要図であり、第2図は、その場合の除理効果の説明図である。

第1図において、1は、処理室であって、2は、 この処理室1内に配置された駆動系の動力源としてのDCモータ、3は、このDCモータ2の内部 に速調する余原株気管であり、4は、処理室1の 内圧を外部より高めるために、窒素ガス(N2) 等を送入する専人質である。

ここで、DCモーク2は、その個体20と、この個体20の内部に収納されたローク21の軸21aを受けるペアリング軸受部22と、ローク21の整施子23に接触するブラン24とを行している。そしてDCモーク2の軸21aがウェハ収り扱い機構5に対し回転力を供給する。

発度排気質3は、外部と筐体20の内部とに速 通していて、筐体20の内側に設置されたステーク(図示せず)に邪魔にならない位置で接続され ている。

この免邀排出管3は、フレキンブルなホースとして構成されてもよいし、金属材料によるパイプであってもよい。図では、直線状に設置しているが、処理室1の装置の設置状態によって、邪魔にならないように配管する。

ここで、処理室1にN2 ガス導入等が導入されると、処理室1の圧力は、外部の圧力より高くなる。これにともなって、DCモータ2の筺体20

内の圧力も外部より高くなって、処理室1内部で 発生するパーテクル、グスト等は、ペアリング軸 受部22を介して、危限排気管3へと流れ、ペア リング軸受部22等の回転部分で発生するダスト 等も発展排気管3へと流れ、ここから外部に排気 なれる

なお、処理窓1に導入されるガスとしてN2を用いた場合、0.05μm程度のフィルタを介してガスを供給したときは、例えば1.0~5.0程度の流量、特に、2.8メ/min 前後の流量でその圧力を観察するとよい。

ところで、モータから発生するパーティクル、 ダストが周囲に拡散する原因を考えてみると、モ ータ内部から出てきたダストのうち比較的大きい ものは、モータの筐体内からやがて排気されるが、 処理案側に浮遊することになる極めて小さなダス ト、パーティクルの除去が問題となる。

それは、ほどんど $1 \, \mu$ m以下の粒子である。この場合、 ℓ ストの沈降速度は、 10^{-3} m ℓ s以下となり、ほとんど空気中に浮遊している状態と

なる。そこで、モーク自身の発熱による滞留によって浮遊しているグストが周囲に拡散していくことを考えると、モータの発熱による空気対流辺度は、モータ表面を100℃とすると次に式より、

$$U_{\text{max}} = \frac{4}{27} \times 5.15 \, \nu \, (\text{Pr} + \frac{20}{21})$$

$$\times \left(\frac{g \, \beta \, (\text{t s} - \text{t } \infty)}{21}\right)^{1/2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Unax = 0.22m/sec となる。

ただし、

ν : 空気の動粘性係数:0.196×10⁻⁴ d/sec

Pr : 空気ブラントル数: 0.71

ts:モータ設而温度;100 ℃

t∞:室瓜

; 20℃

B : 熱膨張係数; 1/293

g :孤力加速度;9.8 m/sec²

х : モータ高さ: 0.05 в

したがって、ほぼ0.22m/sec に十分対抗できる 速度でモータ内部から吸引することによりダスト の拡散を抑えることができる。

特開昭62-98740(4)

第2図(a)及び(b)は、この発明を適用した場合の発展量及び発展率を示すグラフであって、ほぼ第3図に対応する条件のもとで同様なDCモータについて測定したものである。

各図から理解できるように、発展量は、せいぜい数十カウントであり、その発度率も10カウント以下となり、本発明を適用した場合には、発展量がほぼ1/10程度に減少していることが理解できる。

以上説明してきたが、実施例では、モータの堂体に直接発塵排気管を接続しているが、モータの外側をケースで覆い、このケースに連通させてもよい。また、発塵排気管は、外部に直接運通させずに、処理室内部に配置された排気口付近又は排気口部分に連通するようにしてもよい。さらに、排気管は、複数木設けてもよい。

また、実施例では、処理室を中心として説明しているが、これは、処理室手前に配置される準備室であってもよいことはもちろんであり、さらには異物検査装置のX-Yテーブ

クルを負圧側に吸引して処理室又はその準備室等 から外部へ排出することができる。

その結果、特別に発収の少ないモータ密を使用しなくても、通常のDCモータとか、ステッピングモータを使用することが可能となり、安価で長時間使用しても、発煙の少ないシステムを提供することが可能となる。

4.図面の簡単な説明

第1図は、この発明の回転機構の発度防止システムを適用した一実施例の機要図であり、第2図(a)。(b)は、それぞれこの発明を適用した場合のDCモータにおけるの発度最及び発度率の一例を示すグラフ、第3図は、従来のDCモータの発度量のグラフである。

1 …処理室、2 …処理室、3 … D C モータ、
 4 … 発選排気管、2 0 … 億体、2 1 … ロータ、

2 1 a …軸、2 2 …ベアリング軸受部、

23…整流子、24…ブラシ。

ル夢が配牒された室内であってもよい。

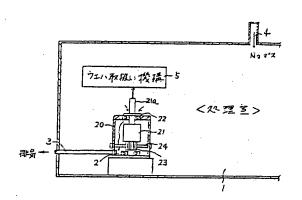
実施例では、DCモークを例として挙げているが、これはステッピングモータ等であってもよく、 回転機一般をはじめとして、回転部分を行する回 転機構に適用できることはもちろんである。

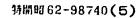
実施例では、半導体製造装置についての例をあ げているが、この発明は、半導体製造装置に限定 されるものではなく、発限が悪影響を与える装置 に適用できることはもちろんである。

[発明の効果]

以上の説明から理解できるように、この発明にあっては、処理室又はその準備室等の気密性のある室内に配置された回転機構と、この回転機構の位体内部又は回転機構を包むケース内に連通する管とを有していて、この管は、処理室又はその準備室の外部に専出され若しくは外部に専出される嫌気の任力より排気側の外部の圧力が低い状態になったので、回転機構の軸受部等から発生するダストや処理室内部で発生するバーテ

第 1 図





第 3 図

